

**КТ8247А**

п-р-п кремниевый  
эпитаксиально-планарный  
высоковольтный транзистор

**Назначение**

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы со встроенным антинасыщающим элементом и встроенным обратным смещенным диодом между эмиттером и коллектором. Предназначены для применения в преобразователях напряжения, пускорегулирующих устройствах осветительных приборов, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

**Зарубежный прототип**

- Прототип – BUL45D2

**Особенности**

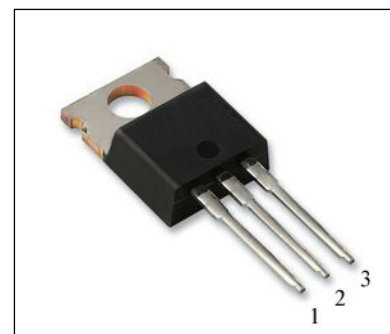
- Диапазон рабочих температур от - 25 до + 125°С

**Обозначение технических условий**

- АДБК 432140.902 ТУ

**Корпусное исполнение**

- пластмассовый корпус КТ-28 (ТО-220)

**Назначение выводов**

Вывод	Назначение
№1	База
№2	Коллектор
№3	Эмиттер

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ8247А при  $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$** 

Параметры	Обозн.	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо гр.	В	$I_{\text{к}}=100\text{ мА}, I_{\text{б}}=0, L=40\text{ мГн}$	400	Тип. 440
Обратный ток коллектора	Iкэк	мкА	$U_{\text{кэ}}=700, U_{\text{эб}}=0$	-	100
Обратный ток эмиттера	Iэбо	мкА	$U_{\text{эб}}=10\text{В}, I_{\text{к}}=0$	-	100
Обратный ток коллектор-эмиттер	Iкэо	мкА	$U_{\text{кэ}}=400\text{ В}, R_{\text{бэ}} = \infty$	-	100
Статический коэффициент передачи тока ( $t_{\text{и}} \leq 300\text{ мкс}, Q \geq 100$ )	$h_{21\text{E}}$		$U_{\text{кэ}}=1\text{ В}, I_{\text{к}}=0,8\text{ А}$ $U_{\text{кэ}}=1\text{ В}, I_{\text{к}}=2,0\text{ А}$	22 10	- -
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $t_{\text{и}} \leq 300\text{ мкс}, Q \geq 100$ )	Uкэ нас	В	$I_{\text{к}}= 2\text{ А}, I_{\text{б}}= 0,4\text{ А}$ $I_{\text{к}}= 0,8\text{ А}, I_{\text{б}}= 80\text{ мА}$ $I_{\text{к}}= 0,8\text{ А}, I_{\text{б}}= 40\text{ мА}$	- - -	0,5 0,4 0,75
Напряжение насыщения база-эмиттер ( $t_{\text{и}} \leq 300\text{ мкс}, Q \geq 100$ )	Uбэ нас	В	$I_{\text{к}}=2\text{ А}, I_{\text{б}}=0,4\text{ А}$ $I_{\text{к}}= 0,8\text{ А}, I_{\text{б}}=80\text{ мА}$	- -	1,0 1,0
Время включения	t вкл	мкс	$U_{\text{кб}}= 300\text{ В}, I_{\text{к}}=2\text{ А}, I_{\text{б1}}= 0,4\text{ А}, I_{\text{б2}}= 1\text{ А}$		0,75
Время выключения	t выкл	мкс	$U_{\text{кб}}= 300\text{ В}, I_{\text{к}}=2\text{ А}, I_{\text{б1}}= 0,4\text{ А}, I_{\text{б2}}= 1\text{ А}$		1,3
Прямое напряжение диода	Uпр	В	$I_{\text{пр}}= 2\text{ А}, t_{\text{и}} \leq 300\text{ мкс}, Q \geq 100$	Тип. 1,2	1,6
Емкость коллекторного перехода	Cк	пФ	$U_{\text{кб}}=10\text{В}, I_{\text{э}}=0, f=1\text{МГц}$		90
Емкость эмиттерного перехода	Cэ	пФ	$U_{\text{эб}}=8\text{В}, I_{\text{э}}=0, f=1\text{МГц}$		600

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ8247А**

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер ( $U_{\text{бэ}} = 0$ )	Uкэк max	В	700
Напряжение коллектор-эмиттер ( $I_{\text{б}} = 0$ )	Uкэ max	В	400
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	12
Постоянный ток коллектора	Iк max	А	5
Импульсный ток коллектора ( $t_{\text{и}} \leq 5\text{ мс}, Q \geq 10$ )	Iк, и max	А	10
Постоянный ток базы	Iб max	А	2
Импульсный ток базы ( $t_{\text{и}} \leq 5\text{ мс}, Q \geq 10$ )	Iб, и max	А	4
Рассеиваемая мощность коллектора ( $T_{\text{корп}}$ от - 25 до + 25 °С)	Pк max	Вт	75
Температура перехода	Tj	°С	150
Тепловое сопротивление переход - корпус	Rtпер-корп.	°С/Вт	норма 1,67



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>